業 解説

活性種のレーザー計測による 大気圧ストリーマ放電の反応機構解明

小野 亮 (東京大学大学院新領域創成科学研究科) (原稿受付:2011年4月11日)

コロナ放電やバリア放電などの大気圧ストリーマ放電は、環境応用、バイオ、医療、表面処理、燃焼支援な ど様々なところで利用されている。これらのストリーマ放電技術では、放電で生成されるラジカル・イオンなど の活性種が重要な役割を果たしている。近年、ストリーマ放電の活性種のレーザー計測が行われるようになり、 これまでよくわからなかった活性種の挙動がしだいに明らかになってきた。本解説ではストリーマ放電の様々な 活性種のレーザー計測を紹介し、その結果明らかになった活性種の生成および反応機構について述べる。また、 活性種の反応速度に影響する振動温度および並進温度のレーザー計測についても紹介する。

Keywords:

atmospheric-pressure nonthermal plasma, streamer, radical, laser-induced fluorescence, vibrational temperature, translational temperature

1. はじめに

大気圧下のコロナ放電やバリア放電では、図1のような フィラメント状の放電が発生する.これをストリーマ放電 と呼ぶ¹.ストリーマ放電は環境改善技術[1-6],オゾン生 成[2,7],バイオ[8,9],医療[10,11],表面処理[2],燃焼 支援[12]など多くの分野で利用されており、放電で生成さ れる活性種 (O, N, OH, O₃ などのラジカル, イオン, 励 起種など)が重要な役割を果たしている.例えば環境改善 技術では, 放電で生成される O, N, OH, O3 などの活性種 が、環境汚染ガス (NOx・SOx・揮発性有機物など)や水 中の環境汚染物質(化学薬品・細菌など)を分解除去する [1,6,13-17]. バイオ技術(殺菌)では、活性種の殺菌反応 や、イオンによる細胞膜の帯電破裂が効果的と考えられて いる[8,9,11]. 医療技術(止血,けが治療,がん治療,歯 科治療)でも、放電で生成される活性種の反応が治療に効 果的と考えられている[10,11]. 燃焼支援技術では燃料を 放電でラジカル化してから燃焼させ、ラジカルの連鎖反応 である燃焼反応を高効率化する[12].

このように、ストリーマ放電の応用技術では活性種が重要であり、技術開発には活性種の計測が必須である.活性種は一般に寿命が短いため(<1 ms)、計測にはレーザー分光による「その場」計測が用いられる.しかしレーザー計測は装置が大がかりで、測定が容易ではなく、ストリーマ放電の計測例は少ない.一方で、シミュレーションによる活性種の研究例は多いが、シミュレーションの妥当性を検証するためにも活性種の計測が必要である.このような

背景のもと,筆者のグループではストリーマ放電の活性種 計測に取り組んでおり,その挙動を明らかにしてきた.本 稿では,筆者のグループの研究を中心にストリーマ放電の 活性種計測を紹介し,その結果明らかになった活性種の生 成および反応機構について述べる.







1 バリア放電のフィラメントはマイクロ放電とよばれることが多いが、その進展機構はストリーマとほぼ同じであり、本解説で はストリーマ放電と呼ぶことにする.

 Study on Reaction Process of Atmospheric-Pressure Streamer Discharge by Measuring Active Chemical Species Using Laser Spectroscopy

 ONO Ryo

 author's e-mail: ryo-ono@k.u-tokyo.ac.jp

2. 活性種の生成と反応

ストリーマ放電による NOx 除去のシミュレーション [14]をもとに,活性種の生成および反応の概略について述 べる.ストリーマ放電では直流・交流・パルスなど様々な 電圧を用いるが,発生する放電はすべて10~数 100 ns のパ ルス放電である[18,19].放電では 1~10 eV 程度の電子が 発生し,背景ガスの中性粒子と衝突反応する.背景ガスは 空気であることが多く,空気中の N₂, O₂, H₂O などと衝突 反応する.その結果,衝突解離反応(例:e+O₂→e+O+ O)や付着解離反応(例:e+O₂→O⁻+O)で, N, O, OH, H などのラジカルが生成される.さらに N⁵₂, N⁴₄, N⁺, O⁵₂, O⁴₄, O⁺, O⁻₂, O⁻, H₂O⁺, H⁻などのイオンや, N₂(ν), N₂($A^{3}\Sigma_{u}^{+}$), N₂($B^{3}\Pi_{g}$), N₂($C^{3}\Pi_{u}$), N₂($a^{1}\Sigma_{u}^{-}$), O₂(ν), O₂($a^{1}\Delta_{a}$), N⁽²D), O⁽¹D)などの励起種も生成される.

電子の衝突反応の他に,活性種の化学反応で生成される 活性種もある.

$O(^{1}D) + H_{2}O \rightarrow OH + OH $	1)
	·	/

$$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M \tag{2}$$

 $O + OH + M \rightarrow HO_2 + M \tag{3}$

NOx 除去プロセスでは、このように生成された活性種が、放電後1µs~1msの時間オーダーで反応してNOxを除去する.NOx は主にNラジカルによる還元反応

$$NO + N \rightarrow N_2 + O \tag{4}$$

$$NO_2 + N \rightarrow NO + NO$$
 (5)

 $NO_2 + N \rightarrow N_2O + O \tag{6}$

あるいは O, O₃, OH ラジカルによる酸化反応

$NO + O + M \rightarrow NO_2 + M$	('	7)	
$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$	()	8)	ļ

$$NO_2 + OH + M \rightarrow HNO_3 + M \tag{9}$$

で除去される.酸化反応の生成物である NO₂や HNO₃ は,溶液で還元して回収することができる[20].酸化反応 と還元反応,どちらが主要な反応パスになるかは放電条件 に依存する.実際の反応にはこれよりもはるかに複雑であ り,シミュレーションでは数10~数100,場合によっては 1000近くにもおよぶ反応式を考慮する[21].

図2に、シミュレーション[14]の結果を参考に描いた、 ラジカルおよび NOx 濃度の放電後の時間変化を概略で示 す.図の「一次ラジカル」は電子衝突で生成される O, N, OH などのラジカルを表す.一次ラジカルは放電パルスで 生成され、その後様々な反応により 1 µs~1 msの時定数で 減少する.図の「二次ラジカル」は、一次ラジカルの反応 で生成される O₃, HO₂ などを表す.二次ラジカルは放電後 1~100 µs で生成され、その後 100 µs~10 msの時定数で減 少する(場合によっては 1 s 以上).NOx は一次および二次 ラジカルと反応して減少する.このような反応の流れはバ イオ、医療、表面処理、燃焼支援でも同じである.いずれ も放電で生成された活性種の反応がポイントになる.

3. 活性種のレーザー計測法

活性種のレーザー計測には様々な手法があるが、その中 でもよく用いられるレーザー吸収法とレーザー誘起蛍光法 (LIF: laser-induced fluorescence) について説明する.

3.1 レーザー吸収法

ある活性種が吸収する波長の光を照射すると,光路上に ある活性種の総数に応じて光が吸収される.その光の吸収 率から活性種の密度を求める手法を吸収法という.図3に 示すように,光の入射端から距離xにおける光強度*I*(*x*) は次式で表される.

$$I(x) = I_0 \exp\left(-\sigma N x\right) \tag{10}$$

ここで I_0 は入射光強度, σ は吸収断面積, N は活性種の密 度である. プラズマの光軸方向の長さを L, プラズマ通過 後の光強度を I_L とすると $N = [1/(\sigma L)] \ln(I_0/I_L)$ が成立し, I_0/I_L の比から密度 N が得られる. ここで N はプラズマ中 で均一と仮定しているが, そうでない場合はこれより複雑 な式になる.

3.2 LIF

LIF は、吸収法よりも感度よく活性種の密度を測定する ことができる.LIF の測定原理を図4に示す.準位1と2 のエネルギー差に相当する波長のレーザーを照射すると、 準位1の活性種がレーザーを吸収して準位2に励起される (図中のB₁₂I_L).準位2は誘導放出(B₂₁I_L),自然放出



図2 ストリーマ放電の NOx 処理におけるラジカルおよび NOx 密度の放電後の時間変化. 放電パルス幅 100 ns. 文献 [14] のシミュレーションの結果を参考に作成.







図4 LIF 測定原理.

 (A_{2i}) , クエンチング (無放射遷移: Q_2) で脱励起する. 自 然放出で放射される蛍光強度 I_{LIF} は,準位 1 の密度 N_1 に比 例する $(I_{LIF} \propto N_1)$. 蛍光強度 I_{LIF} を測定し,密度 N_1 を得 ることができる. I_{LIF} と N_1 の比例関係は,実際にはクエン チングの影響などによりもう少し複雑になる[22].

LIF計測で得られる密度 N_1 は, 正確には活性種の密度で はなく,活性種のある回転準位の密度である.回転準位 Jの密度を N_J , エネルギーを E_J , 全回転準位の密度を足した 総密度を $N(=\Sigma N_J)$, 活性種の回転温度を T_r とおくと, N_J は次のボルツマン分布に従う.

$$\frac{N_J}{N} = \frac{g_J \exp\left[-E_J/(kT_r)\right]}{Q_r} \tag{11}$$

ただし g_J は統計重率, $Q_r = \sum g_J \exp[-E_J/(kT_r)]$ である. 我々が測定したいのは, N_J ではなくNである.レーザーの 波長を変えていくつかの回転準位の密度 N_J を測定すれば, 式(11)を用いて活性種の回転温度 T_r が得られ,さらにNも得られる.大気圧では並進温度と回転温度は一般に等し いとみなせるので, T_r から並進温度も得られる.

4. ストリーマの進展機構

ストリーマ放電による活性種の生成機構を調べるには, まず最初にストリーマ放電そのものの発生機構を理解する 必要がある.本節では筆者のグループの研究をもとに,ス トリーマの進展機構について述べる.

図5に筆者のグループで用いている放電リアクタを示 す.放電はこのような箱型リアクタ内で、13 mm 間隔の針 - 平板電極を用いて発生させる.図5では25本の針電極が 4 mm 間隔で一列に並んでいるが、実験に応じて針の本数 は1~25本の範囲で変化させることができる.平板電極を 接地し、針電極に図6(a)のような数100 ns 幅の正極性パ ルス電圧を印加する.このとき電極間にストリーマ放電が 発生し、図6(b)のような電流が流れる.高電圧パルスは、 コンデンサとスパークギャップスイッチで発生させる.電



図5 放電リアクタ.

Eのパルス幅は、電極と並列に取りつけた抵抗の値で調節 する.図6の波形は、コンデンサを32kVに充電したとき のものである(V=32kV).放電パルスは1秒に1パルス 程度の周期で印加する.リアクタには大気圧の空気や窒素 -酸素混合気を2L/minの流量で流し(リアクタ内の流速 2 cm/s)、バブリング装置で湿度を変えられるようになっ ている.

ゲート時間5nsのICCDカメラで撮影した,ストリーマ の進展写真を図7に示す.最初の3枚の写真で,粒状の発 光領域が針電極から平板電極へ進展している.これはスト リーマ・ヘッド,あるいは一次ストリーマとよばれてい る.ストリーマ・ヘッドは電界が極めて強く,背景ガスを 電離しながら進展する.ストリーマ・ヘッドが通過した領 域には,フィラメント状の導電性領域が形成される.スト



図6 放電電圧および電流波形の例.加湿した O₂(2%)/N₂ 雰囲 気.針電極1本. V = 32 kV[22].



二次ストリーマ

 図7 ICCD カメラで撮影したストリーマの進展写真. 針電極1 本, O₂(10%)/N₂放電, V = 27 kV.

Commentary

リーマ・ヘッドが平板電極に到達すると、この導電領域に 沿って再びストリーマが進展する.これは二次ストリーマ と呼ばれている.図7に示すように、二次ストリーマは針 電極から電極間の途中までしか進展せず、平板電極には到 達しない(詳細については[23]参照).このような一次ス トリーマと二次ストリーマの進展は、図8のストリークカ メラで撮影した写真にも明瞭に観測されている.

電子の平均エネルギーは、一次ストリーマで5~ 10 eV,二次ストリーマでは1 eV 程度と考えられている [18,24,25].両者で電子エネルギーが大きく異なるため、 後述するように、両ストリーマの活性種の生成効率も著し く異なる.

以上,針電極に正極性電圧を印加した正ストリーマについて述べた.本稿では、この正ストリーマの活性種計測について紹介する.負ストリーマでは、正ストリーマと異なる進展特性や活性種の挙動が観測されるが、本解説では紙面の都合上紹介しない[26,27].

5. ストリーマ放電の活性種計測

表1に示した,筆者のグループの一連の活性種計測について紹介する[22,28-33].いずれも正極性パルスコロナ放電での計測で,O₃は吸収法,その他はLIF法で計測している.OHとO₂(v = 6)はクエンチングによる誤差を減らす前期解離LIF(LIPF: laser-induced predissociation fluorescence),OとNは2つの光子を同時に吸収させて励起する二光子励起LIF(TALIF: two-photon absorption LIF)で測定しているが,どちらも基本的な原理はLIFと同じである.この他にも、いくつかのグループがO₃,OH,NO,N,N₂($A^{3}\Sigma_{u}^{*}$)などの計測をストリーマ放電で行っている[34-43].



図8 ストリークカメラで撮影したストリーマの進展写真. 図7 とは異なる条件で放電させている.

計測には図5のようなリアクタを用い,放電パルスの周 期を1秒に1パルス程度とする.パルスコロナ放電の応用 技術では,1秒に数10~100以上のパルスを印加すること が多いが,活性種計測では周期を低く抑えることで,背景 ガスに蓄積する放電生成物(O₃, NOx, HNO₃ など)を極 力低く抑えている.背景ガスの組成をシンプルにして,活 性種測定結果の分析を容易にしている.

図9に測定のタイムチャートを示す.活性種密度は放電 パルスで増加し,その後減少する.レーザーパルスを放電 パルスから時間tだけ遅らせて照射し,放電後t秒後におけ る活性種密度を計測する.この遅れ時間tを様々に変化さ せて,活性種密度の放電後の時間変化を測定する.レー ザーのパルス幅は20 ns程度なので,この測定の時間分解 能も20 ns程度である.

5.1 二次元吸収法によるオゾン計測

筆者らは図10のような手法で、オゾン濃度の二次元分布 を計測した[28].図10(a)では断面 120×16 mm²のビーム



図10 オブンの二次九吸収計測[20]

表1 筆者のグループが行った活性種計測.O3 は吸収法,その他は LIF で計測.

	LIF の励起遷移と波長	[nm]	LIF の蛍光遷移と波長	[nm]	測定法	文献
O ₃					吸収法	[28]
OH	$A^{2}\Sigma - X^{2}\Pi$ (3, 0)	248	$A^{2}\Sigma - X^{2}\Pi$ (3, 2)	297	LIPF	[22]
Ο	3p ³ P -2p ³ P	226	$3p^{3}P$ - $3s^{3}S$	845	TALIF	[29]
Ν	$3p{}^4S{}^\circ ext{-}2p{}^{3,4}S{}^\circ$	207	$3p {}^{4}S {}^{\circ}$ - $3s {}^{4}P$	745	TALIF	[29]
$N_2(A^3\Sigma_u^+)$	$B^{3}\Pi_{g} A^{3}\Sigma_{u}^{+}$ (4, 0)	618	$B^{3}\Pi_{g} A^{3}\Sigma_{u}^{+}$ (4, 1)	676	LIF	[30]
NO	$A^{2}\Sigma^{+}-X^{2}\Pi$ (0, 0)	226	$A^{2}\Sigma^{+}-X^{2}\Pi$ (0, 3)	259	LIF	[32]
$O_2(v = 6)$	$B^{3}\Sigma_{u}^{-}-X^{3}\Sigma_{g}^{-}$ (0, 6)	248	$B^{3}\Sigma_{u}^{-}-X^{3}\Sigma_{g}^{-}$ (0, 13)	321	LIPF	[33]

を照射し,放電領域透過後のビーム断面を蛍光ガラス板に 投影している.放電領域でのオゾン濃度分布に応じてビー ムが吸収されるため,ガラス板に投影されたビームパター ンから放電領域のオゾン濃度分布が得られる.図11に放電 の写真,図12にオゾン濃度分布の放電後の時間変化(拡大 図)を示す[28].各画像の下に記されている時間は,放電 終了後からの経過時間である.測定感度が低いためにノイ ズの多い画像となっているが,ストリーマ1本ずつで生成 されたオゾンが観測されている.1ms以降はオゾンが拡散 し,さらに背景ガスの流れによって図の左から右に流され ている様子が観測されている.

図10(b)のようにリアクタの長軸方向にビームを照射 し、オゾン濃度分布を測定した結果を図13に示す[28].こ の測定は先の測定よりも吸収長が長いので、測定感度がよ くなっている.5µsと20µsに表れている円状と線状のノイ ズは、後述するように放電で発生した圧力波である.放電 後100µsまでは、反応(2)によるオゾン生成反応でオゾン 濃度が増加している.このオゾンの増加速度から、本放電 下での反応(2)の反応係数は3.5×10⁻³⁴ cm⁶/sと得られ る.このように、活性種密度の放電後の時間変化から、活 性種の反応速度を求めることができる.

図13では、オゾンが針電極から一定の距離までしか生成 されず、平板電極付近ではほとんど生成されていない.こ れはオゾンが主に二次ストリーマで生成されていることを 示している.図14に放電電圧を18,24,30 kVとしたとき の、放電発光強度とオゾン濃度の軸方向分布を示す.横軸 は針電極からの距離で、縦軸は適宜規格化している.図14





図13 リアクタ長軸方向から観測したオゾン分布の放電後の時間 変化. 乾燥空気、V = 26 kV[28].

(a)の灰色の部分が二次ストリーマ,残りの部分が一次ス トリーマの発光である.電圧が増加すると,二次ストリー マの進展長が伸びていることが分かる.図14(a)と(b)を比 較すると,どの電圧でもオゾン濃度分布と二次ストリーマ の発光分布がよく一致している.これは,オゾンが主に二 次ストリーマで生成されていることを示している.

5.2 LIF による OH ラジカルー次元分布計測

次に OH の LIF 計測について紹介する. 図15に LIF 計測 法を示す. 断面 2×8 mm² のレーザーを, 針電極から z mm の距離に照射して OH を励起する. 励起した OH の放射す る蛍光は, レーザーと垂直の方向から計測する. 光検出器 側のスリット幅を調節して, 図に示した 2×8×8 mm³の測 定領域内部の OH の蛍光を測定する. この測定で, 測定領 域内の OH ラジカルの分子数が得られる. これを測定領域 内のストリーマの体積で除すれば OH 密度が得られる. 測 定領域の水平断面を 8×8 mm² と広くとることで, 図1 (a) のように広がりをもつストリーマの大部分が測定領域を通 過するようにし, 測定に漏れる OH がなるべく少なくなる ようにしている. 針電極とレーザーの距離 z を変化させて,



図14 (a)ストリーマ発光強度*L*とオゾン密度[O₃]の軸方向分布. *V* = 18, 24, 30 kV[28].



Commentary

軸方向の OH 密度分布を測定する.ここに示したのは OH-LIF の測定法であるが,他の活性種の LIF も同様の手法で 測定する.

放電後の様々な経過時間における OH 密度の軸方向分布 を,図16に示す[22].横軸の z は針電極先端からの距離で ある(図15参照). OH 密度は放電後に減少しているが,針 電極先端付近のみ減少速度が遅い.これは後述するよう に,針電極先端付近のみ温度が極端に高いためである(図 24参照).OH は次式のように,再結合反応やOラジカルと の反応で減少する.

$OH + OH \rightarrow H_2O + O$	(12)
$OH + OH + M \rightarrow H_2O_2 + M$	(13)

$$OH + O \rightarrow O_2 + H \tag{14}$$

これらの反応は,高温でも低温でも発生する.一方,高温 下では次の OH 生成反応も活発になる.

$O + H_2O \rightarrow OH + OH$	(15)
$H + O_2 \rightarrow OH + O$	(16)

これらの反応は、高温下でのみ発生する.針先端付近では この OH 生成反応も活発化するため、図16では OH の減少 速度が遅くなっている.

図16では、放電直後(3µs)のOH密度が針電極から遠ざ かるほど低くなっている.これはオゾンと同様、OHも主 に二次ストリーマで生成されていることを示している.こ のようにLIF 計測を用いて、放電による活性種の生成およ び放電後の反応機構を詳細に分析することができる.レー ザー計測は、ストリーマ放電の反応機構を調べる上で強力 なツールとなる.

5.3 一次・二次ストリーマと活性種の生成

ここまで述べたように、オゾンと OH ラジカルは主に二 次ストリーマで生成される.この他、O ラジカルと N ラジ カルも、主に二次ストリーマで生成されることが確認され ている[27,29].一方、N₂(A³Σ⁺_u)は図17に示すように一次 ストリーマの発光分布と同じような平らな分布をしてお



図16 OH分布の放電後の時間変化. H₂O(2.8%)/O₂(2%)/N₂雰囲 気、V = 32 kV[22].

り,主に一次ストリーマで生成されていることがわかる. この他,N¹₂($B^{2}\Sigma_{u}^{+}$)は一次ストリーマ,NOは二次ストリーマ,N₂($C^{3}\Pi_{u}$)は両者で生成されることが放電の発光計測 で確認されている[44,45].このように,活性種の種類に よって一次・二次ストリーマのどちらで生成されるかが異 なる.一次・二次ストリーマの消費エネルギーの比率は,放 電電圧によって変化する.電圧が高いほど,一次ストリー マに対する二次ストリーマの比率が高くなる[46].した がって放電で得られる活性種の種類別の比率も,放電電圧 によって変化する.

O₃, OH, O, N, NO は主に二次ストリーマで生成される が、二次ストリーマは消費エネルギーも大きいため、これ は必ずしも生成エネルギー効率が一次ストリーマより高い ことを意味しない. 筆者のグループでは生成エネルギー効 率も二次ストリーマが高い兆候を観測しているが[22], こ れとは反対の結果も別のグループで観測されており[47], 今後さらに検討が必要である.

5.4 放電後の活性種密度の時間変化

5.4.1 O ラジカルとオゾン

 O_3 は放電後に反応(2)で生成され、その後数10 μ sの時 定数で増加する.反応(2)ではOラジカルを消費するた め、O₃の増加とともにOラジカルが減少する.図18に、O とO₃密度の放電後の時間変化を示す[29].O₂(10%)/N₂ およびO₂(20%)/N₂雰囲気で測定しており、どちらもO の減少速度とO₃の増加速度がよく一致している.また、そ の減少・増加速度は文献値[48] とよく一致している.こ れは、放電で生成されたOラジカルのほぼすべてが反応 (2)でO₃に変換され、反対にO₃はほぼすべてが反応(2) でOラジカルから生成されていることを示している.ただ しこれは乾燥雰囲気でのみ成立し、次に述べるように加湿 雰囲気では成立しない.

背景ガスを加湿すると、O ラジカルは反応(2)以外でも 減少する.図19はO 密度の放電後の時間変化を、様々な湿 度について測定した結果である[49].放電で生成されるO 密度($t \simeq 0 \mu s$)は湿度によらず一定であるが、放電後の減 少速度が高湿度下で速いことがわかる.すなわち、O ラジ カルとOHやH₂Oが反応し[反応(14)(15)],反応(2)以外



図17 N₂(A³Σ[†])および放電発光分布の比較.O₂(0.25%)/N₂雰囲 気, V=21.5 kV, t=4 μs. 灰色の部分は二次ストリーマ, 残 りの部分は一次ストリーマの発光[31].



図18 O および O₃ 密度の放電後の時間変化. O は TALIF,O₃ は吸 収法で測定した. O₂(20%)/N₂ と O₂(10%)/N₂ 雰囲気. O 密度は 0 µs の値で規格化し, O₃ 密度は 200 µs の値で規格 化している. V = 36 kV, z = 1.5 mm[29].



図19 様々な湿度における放電後のO密度時間変化. 空気雰囲気のパルスバリア放電. V = -40 kV, z = 0.3 mm[49].

でも O ラジカルが消費されている.ただし図19はガス温度 が高い針電極先端付近 (z = 0.3 mm) での測定である.ガス 温度の低い z > 1 mm の領域では図19と違う特性が見られ るかもしれず,さらに検討が必要である.

5.4.2 OH ラジカル

OH ラジカルは図16に示すように, 10~100 μs の時定数 で減少する. OH は再結合反応(12)(13)で減少するため, OH 密度が高いほど減少速度が速い. また O ラジカルとの 反応(14)でも減少するため,背景ガスのO2濃度が高いほど 減少が速い[50]. このように OH の減少速度は様々な要因 に依存するが,ここで扱っているようなパルスコロナ放電 では概ね 10 μs から 1 ms 程度の時定数で減少する.

5.4.3 N ラジカル

N₂雰囲気で測定した,N密度の放電後の時間変化を図20 に示す[30].N密度は放電後1ms程度の時定数で減少して いる.N₂雰囲気では,Nラジカルは主に再結合反応

$$N + N + M \rightarrow N_2 + M \tag{17}$$



図20 放電後のN密度時間変化と、様々なNの初期濃度における時間変化の計算結果. t = 20 μsの値で規格化している. N₂ 雰囲気、V = 21.5 kV, z = 0.5 mm[30].

で減少する.したがってN密度によってNラジカルの減少 速度は変化する.図20の実線は,t=0 µs でのN密度を250, 500,1000 ppm と仮定したときの計算結果である(拡散も 考慮している).この計算結果と比較すると,測定したN 密度はt=0 µs でおよそ 500 ppm と見積もられる.

背景ガスに O₂ が含まれると, N ラジカルは O₂ 分子とも 反応する.

$$N + O_2 \rightarrow NO + O$$
 (18)

また,放電で生成された NO とも反応(4)で反応する.したがって背景ガスのO2濃度が増えると,Nラジカルの減少速度は図20よりも著しく加速される.

5.4.4 準安定準位 N₂(A³Σ⁺₄)

 $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ は O_2 と極めて高速に反応する.

$$N_2(A^3\Sigma_u^+) + O_2 \rightarrow N_2 + O + O$$
⁽¹⁹⁾

したがって背景ガスに O_2 が1%でも存在すると, N₂($A^3\Sigma_u^+$)は放電後1µsほどで減少する[31].一方N₂雰囲 気では, N₂($A^3\Sigma_u^+$)は主に再結合反応で減少するため,減少 速度はN₂($A^3\Sigma_u^+$)密度に依存する.例えばNラジカルを測 定した**図20**と同じ放電条件では, N₂($A^3\Sigma_u^+$)はNよりも10 倍程度速く減少する[31].

5.5 活性種の絶対密度

様々な放電条件で測定した活性種の絶対密度を表2に示 す.O₃は光の吸収率,OHはLIF信号強度,NとN₂($A^{3}\Sigma_{u}^{+}$) は図20のように再結合反応速度から密度を求めている.O 密度は表2に記載していないが,先に述べたように乾燥雰 囲気ではOラジカルはほとんどすべてO₃に変換されるの で,放電直後($t \approx 0 \mu s$)のO密度は表2のO₃密度とおおよ そ等しいと考えられる.

表2の密度はそれぞれに誤差要因があり、各測定値には 少なくとも2~3倍の誤差が存在すると考えられる.活性種 の密度は放電電圧、ガス組成、針電極からの距離、放電後 の時間、針電極の本数に強く依存する.表2の各密度は、 各活性種の測定に適した放電条件で測定しているため、そ れぞれ測定条件がばらばらで一概に比較するのは難しい.

表2の密度は、ストリーマの径方向に密度が均一に分布

表2 活性種の密度. z:針電極先端からの距離, t:放電後の経過時間.

	密度 [ppm]	電圧 「kV]	背景ガス	z [mm]	t [µs]	針電極の 本数	測定法	文献
O3	3000	36	Dry air	2	100	25	吸収法	[28]
OH	100	32	${ m H_{2}O(2.8\%)/O_{2}(2\%)/N_{2}}$	2	3	1	LIF	[22]
Ν	500	21.5	N_2	0.5	0	1	再結合反応速度	[30]
$N_2(A^3\Sigma_u^+)$	2	21.5	N_2	6	0	1	再結合反応速度	[51]

していると仮定して求めている.しかし実際には分布が均 ーでない可能性があり、その場合は特に再結合反応速度か ら求めた密度が**表2**の値と大きく異なる可能性がある.例 えば径方向に正規分布を仮定すると、最も密度の高いスト リーマの中心軸での $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ 密度は、**表2**の値の6倍程度 大きくなる可能性がある[52].

5.6 NO 分解反応の計測

ストリーマ放電の応用に関連したレーザー計測の例とし て、ストリーマ放電のNO除去をレーザー計測した例を 図21に示す.NO(200 ppm)/N₂ 雰囲気でパルスバリア放電 を発生させ、NOが分解される様子を二次元LIFで測定し た結果である[32].シート状のレーザーを照射し、シート と垂直方向からICCDカメラでNOの蛍光を撮影して、NO 密度の二次元分布を測定している.図21では、NOがN ラジカルにより分解される様子が観測されている[反応 (4)].この分解反応は10 μs 以下の時定数で進展するた め、ストリーマ内のNOは放電後すぐに分解され、その後 はNの拡散により周辺のNOが分解されている[53].

6. 振動温度と並進温度の計測

振動温度や並進温度は、電子の衝突反応や化学反応の速 度に強く影響する.本節では振動温度と並進温度の測定に ついて紹介する.

6.1 振動温度

ストリーマ放電では、放電エネルギーの大部分が分子の 振動エネルギーの増加に消費され、並進エネルギーはわず かしか増加しない.その結果、放電後の振動温度 T_v は並進 温度 T より高くなる [15,54].放電後、 T_v は振動-並進 (V-T: vibration-to-translation)緩和により減少し、同時に Tが増加する.N₂やO₂の V-T緩和時間は空気中では 1 ms 以上と長いため [55,56]、ストリーマ放電では V-T緩和が 考慮されないことが多い.V-T緩和の前に活性種反応の多 くが終わってしまうので、活性種反応に対する影響が強く 現れないためである.

一方,筆者らは湿度と V-T 緩和の関係を調べ,加湿雰囲気では V-T 緩和が著しく加速され,その影響が無視できなくなることを示した[33,57].加湿空気中では,O₂と H₂O は数μsで振動-振動(V-V:vibration-to-vibration)緩和し,O₂の振動エネルギーが H₂O の振動エネルギーに遷移する[58].

$$O_2(v) + H_2O(000) \rightarrow O_2(v-1) + H_2O(010)$$
 (20)

H₂OはV-T緩和速度がO₂やN₂より8~9桁も速いため,振動励起したH₂O(010)はすぐにV-T緩和する[59,60].加湿



図21 NO (200 ppm) /N2 のパルスバリア放電で NO が分解され る様子. V = 25 kV[32].



図22 O₂(v = 6)密度の放電後の時間変化.加湿および乾燥空気. H₂O 濃度 0, 0.7, 1.4, 2.4%[33].

空気では、この V-T 緩和は 10~100 ns オーダで進展する. その結果、 $O_2(v)$ は H_2O を介して数 μ s で V-T 緩和する. $N_2(v)$ はもう少し遅いが、やはり H_2O を介して高速に V-T 緩和する[61].様々な湿度下で、 $O_2(v=6)$ の減少速度 を LIF 計測した結果を**図22**に示す[33].湿度が増すと、 $O_2(v)$ の V-T 緩和が加速されているのが確認できる.同様 に、加湿すると放電後の並進温度増加が加速される様子も 観測されている[62,63].

分子の振動温度は、V-T 緩和の他にもう一つ重要な側面 をもつ.以下のような分子の付着解離反応

$$e + O_2 \rightarrow O^- + O \tag{21}$$

の反応断面積は、分子の振動温度に強く依存する[64-66]. 図23は $T_r = T_v = 300$, 1400, 2200 K のときの反応 (21)の反応断面積である (T_r は回転温度)[64]. 300 K か ら 2200 K へ変化したときのエネルギーの増分はわずか 0.2 eV 程度であるが、反応断面積の曲線は低エネルギー側 に 3 eV 近くも広がっている. これは T_r ではなく T_v の影響 であり、 $T_r = 300$ K のまま T_v のみ変化させても同じような 結果が得られる[64]. このように T_v が高くなれば、4 eV 以下の低エネルギー電子でも O⁻や O の生成が十分に可能 となる.

先に述べたように、0 ラジカルは主に二次ストリーマで



図23 T_r = T_v = 300, 1400, 2200 Kのときの O₂ 付着解離反応断面 積の計算値[67]. 文献[64]の表1をプロット.

生成される. O ラジカルを生成する反応 e + O₂→e + O+O と反応(21)の閾値はそれぞれ 5.1 eV と 3.6 eV で,二次スト リーマの平均電子エネルギー(1~2 eV)よりもはるかに高 い値であるが,一次ストリーマ(5~10 eV)よりも多くの O ラジカルを生成している.二次ストリーマのほうが電流 が大きいことが理由の 1 つであるが,この他に二次スト リーマでは O₂の振動温度が高いため[67],低エネルギー 電子による反応(21)のO ラジカル生成効率が高くなってい る可能性がある.この他,振動準位などの励起準位を介し た多重励起により,電子の衝突解離反応が低エネルギー側 で発生している可能性もある.

筆者らは、コヒーレント・アンチストークス・ラマン分 光法(CARS: coherent anti-Stokes Raman scattering)によ る、N₂の振動分布計測も行っており、N₂(v)のV-V、V-T 緩和および、加湿によるV-T 緩和の加速を観測している [68].ストリーマ放電では、v = 0のみ平衡から外れた非平 衡分布となることが計算で予測されているが[24]、このよ うな非平衡分布も観測されている.CARSもストリーマ放 電の反応機構を調べる上で強力なツールとなる.



 図24 OH-LIF で測定した、温度分布の放電後の時間変化. H₂O
 (2.8%)/O₂(2%)/N₂ 雰囲気、V = 32 kV. 放電後 0 µs のみ放 電の発光スペクトルを用いて測定している[22].

6.2 並進温度

放電後の並進温度の時間変化を,OH-LIF で測定した結 果を図24に示す[22]. 横軸は針電極先端からの距離で,温 度の位置分布をプロットしている.加湿雰囲気で測定して いるため V-T 緩和が速く,放電後に著しく温度が上昇して いる.また,針電極先端近傍(測定の空間分解能を考慮す ると針電極から1mm 程度の範囲内)で特に温度が高く なっている.並進温度は化学反応速度に強く影響するた め,このような放電後の複雑な温度変化は,活性種の反応 を調べる上で極めて重要である.

6.3 ストリーマのガス密度

ストリーマ放電では、図24のようにストリーマのガス温 度が上昇するため、ストリーマのガス密度は背景ガスの密 度より低くなる.図25はシャドウグラフ法で、放電後のガ ス密度の時間変化を測定した結果である[63].シャドウグ ラフは、気体の屈折率の変化を影絵のように可視化する技 術である[69].ストリーマ内部ではガス密度が減少して屈 折率が変化しているため、そこに平行光を照射して光を屈 折させてからスクリーンに投影し、可視化している.図25



図25 ガス密度の放電後の時間変化. ガス密度の径方向分布にガウス分布を仮定し,中心軸上の密度を №, 周辺の密度を № とおいている. 加湿空気, V = 32 kV [63].

Commentary

の3~100 μsでは, 放電後のV-T反応でガスが加熱され, 密 度が次第に減少する様子が観測されている. 同じような傾 向は, 直流コロナ放電でも観測されている[70,71]. 図25の 30~600 μs では, 針電極に近いほど密度が低くなってい る. これは二次ストリーマ領域でガス温度が高いことを示 している.

図24でも示したように、針電極先端付近は極めて温度が 高くなる.その結果、針先端を中心とした圧力波が発生す る.この圧力波をシュリーレン計測した結果を図26に示す [62].針電極を25本並べ、図10(b)のようにレーザーを照 射して測定した結果である.シュリーレンもシャドウグラ フと同様に、気体の屈折率変化を可視化する手法で、測定 手法もほとんど同じである[69].図26では針先端を中心 に、球状の圧力波が音速で進展する様子が観測されてい る.このような圧力波はシミュレーションでも再現されて いる[72].図26では、平板電極から平面状の圧力波も発生 していることが確認できる.

7. おわりに

レーザー計測はストリーマ放電の反応機構を調べる上で 強力なツールであり,活性種密度や温度の,空間分布や時 間変化を測定することができる.ストリーマは,極めて小 さいストリーマ・ヘッドが高速に進展し,フィラメントが 複雑に枝分かれする.このような空間的,時間的に変化の 大きい放電の反応をシミュレーションで予測するのは現状 では難しく,反応機構を明らかにする上でレーザー計測が 果たす役割は大きい.レーザー計測で得られた結果をもと にした,ストリーマ放電の完全なシミュレーションの完成 が待たれる.

ストリーマは空間的、時間的に変化の大きな現象なの で、シミュレーションでは空間メッシュや時間ステップを かなり細かくとる必要がある.そのため膨大な計算時間が かかる.計算機の性能向上に伴い,近年ではストリーマの 進展を精密に計算できるようになってきたが、以前はスト リーマの平均電界強度を用いて、電界強度は時間的・空間 的に一定という仮定のもとで活性種のシミュレーションが 行われていた.活性種は電子エネルギーの高い一次ストリー マで生成されるという考えと、放電時間が長く電流の大き い二次ストリーマで生成されるという考えがあり、いずれ の場合も片方だけを考慮することが多かった. しかし実際 にレーザー計測してみると,活性種の種類によってどちら で生成されるかが異なり、さらに空間的に不均一な分布と なっていることが明らかとなった. また, ガス温度と振動 温度を室温と仮定したシミュレーションがほとんどであっ たが、これも場合によっては不適切であることがレーザー 計測で明らかになった.近年では、ストリーマの進展から 活性種の反応までを計算し、一次・二次ストリーマによる 活性種の生成や、空間分布、温度変化などがしだいに再現 できるようになってきた. 筆者のグループでもシミュレー ションの開発に着手しており、実験と計算の両面からスト リーマ放電の研究に取り組んでいる.今後,この分野の研 究がさらに活発化し、測定結果を再現できるようなシミュ



図26 圧力波のシュリーレン像.加湿 N₂, V = 26 kV[62].

レーションが開発されるよう、今後の進展に期待したい.

参 考 文 献

- [1] J.S. Chang, P.A. Lawless and T. Yamamoto, IEEE Trans. Plasma Sci. 19, 1152 (1991).
- [2] U. Kogelschatz, Plasma Chem. Plasma Process. 23, 1 (2003).
- [3] T. Oda, J. Electrostat. 57, 293 (2003).
- [4] H.H. Kim, Plasma Process. Polym. 1, 91 (2004).
- [5] B.R. Locke, M. Sato, P. Sunka, M.R. Hoffmann and J.S. Chang, Ind. Eng. Chem. Res. 45, 882 (2006).
- [6] M.A. Malik, Plasma Chem. Plasma Process. 30, 21 (2010).
- [7] B. Eliasson, M. Hirth and U. Kogelschatz, J. Phys. D: Appl. Phys. 20, 1421 (1987).
- [8] M. Laroussi, IEEE Trans. Plasma Sci. 30, 1409 (2002).
- [9] M. Laroussi, Plasma Process. Polym. 2, 391 (2005).
- [10] G. Fridman, G. Friedman, A. Gutsol, A.B. Shekhter, V.N. Vasilets and A. Fridman, Plasma Process. Polym. 5, 503 (2008).
- [11] M.G. Kong, G. Kroesen, G. Morfill, T. Nosenko, T. Shimizu, J. van Dijk and J.L. Zimmermann, New J. Phys. 11, 115012 (2009).
- [12] S.M. Starikovskaia, J. Phys. D: Appl. Phys. 39, R265 (2006).
- [13] J.J. Lowke and R. Morrow, IEEE Trans. Plasma Sci., 23, 661 (1995).
- [14] A.C. Gentile and M.J. Kushner, J. Appl. Phys. 78, 2074 (1995).
- [15] O. Eichwald, M. Yousfi, A. Hennad and M.D. Benabdessadok, J. Appl. Phys. 82, 4781 (1997).
- [16] M.A. Malik, A. Ghaffar and S.A. Malik, Plasma Sources Sci. Technol. 10, 82 (2001).
- [17] P. Lukes and B.R. Locke, Ind. Eng. Chem. Res. 44, 2921 (2005).
- [18] E. Marode, J. Appl. Phys. 46, 2005 (1975).
- [19] B. Eliasson and U. Kogelschatz, IEEE Trans. Plasma Sci.
 19, 1063 (1991).
- [20] T. Yamamoto, C.L. Yang, M.R. Beltran and Z. Kravets, IEEE Trans. Ind. Applicat. 36, 923 (2000).
- [21] H. Mätzing, Adv. Chem. Phys. 80, 315 (1991).
- [22] R. Ono and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 41,035204 (2008).
- [23] R.S. Sigmond, J. Appl. Phys. 56, 1355 (1984).
- [24] M. Šimek, S. DeBenedictis, G. Dilecce, V. Babický, M. Člupek and P. Šunka, J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 1981 (2002).
- [25] O. Eichwald, O. Ducasse, D. Dubois, A. Abahazem, N. Merbahi, M. Benhenni and M. Yousfi, J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 234002 (2008).

- [26] Y. Teramoto, Y. Fukumoto, R. Ono and T. Oda, IEEE Trans. Plasma Sci. *under submission*.
- [27] 寺本慶之,小野 亮,小田哲治:静電気学会講演論文集 2010,211 (2010).
- [28] R. Ono and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 37, 730 (2004).
- [29] R. Ono, K. Takezawa and T. Oda, J. Appl. Phys. **106**, 043302 (2009).
- [30] R. Ono, Y. Teramoto and T. Oda, Jpn. J. Appl. Phys. 48, 122302 (2009).
- [31] Y. Teramoto, R. Ono and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 235205 (2009).
- [32] R. Ono and T. Oda, Int. J. Plasma Environ. Sci. Technol. 1, 123 (2007).
- [33] R. Ono. Y. Teramoto and T. Oda, Plasma Sources Sci. Technol. 19, 015009 (2010).
- [34] H. Sugimitsu and S. Okazaki, J. Chim. Phys. Phys. Chim. Biol. 79, 655 (1982).
- [35] F. Hegeler and H. Akiyama, IEEE Trans. Plasma Sci. 25, 1158 (1997).
- [36] J.J. Coogan and A.D. Sappey, IEEE Trans. Plasma Sci. 24, 91 (1996).
- [37] G.J. Roth and M.A. Gundersen, IEEE Trans. Plasma Sci. 27, 28 (1999).
- [38] H. Hazama, M. Fujiwara and M. Tanimoto, Chem. Phys. Lett. **323**, 542 (2000).
- [39] R. Sankaranarayanan, B. Pashaie and S.K. Dhali, Appl. Phys. Lett. 77, 2970 (2000).
- [40] S. Kanazawa, T. Ito, Y. Shuto, T. Ohkubo, Y. Nomoto and J. Mizeraczyk, IEEE Trans. Ind. Applicat. **37**, 1663 (2001).
- [41] C. Lukas, M. Spaan, V. Schultz-von der Gathen, M. Thomson, R. Wegst, H.F. Döbele and M. Neiger, Plasma Sources Sci. Technol. 10, 445 (2001).
- [42] G. Dilecce, P.F. Ambrico and S.D. Benedictis, Plasma Sources Sci. Technol. 16, 511 (2007).
- [43] S. Kanazawa, H. Tanaka, A. Kajiwara, T. Ohkubo, Y. Nomoto, M. Kocik, J. Mizeraczyk and J.S. Chang, Thin Solid Films 515, 4266 (2007).
- [44] Y.L. M. Creyghton, E.M. van Veldhuizen and W.R. Rutgers, IEE Proc.-Sci. Meas. Technol. 141, 141 (1994).
- [45] R. Ono and T. Oda, J. Appl. Phys. 97, 013302 (2005).
- [46] R. Ono and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 36, 1952 (2003).
- [47] D. Wang, T. Matsumoto, T. Namihira and H. Akiyama, J. Adv. Oxid. Technol. 13, 71 (2010).
- [48] R. Atkinson et al., J. Phys. Chem. Ref. Data 21 1125 (1992).
- [49] R. Ono, Y. Yamashita, K. Takezawa and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 38, 2812 (2005).
- [50] R. Ono and T. Oda, J. Appl. Phys. 93, 5876 (2003).
- [51] R. Ono, C. Tobaru, Y. Teramoto and T. Oda, Plasma Sources Sci. Technol. 18, 025006 (2009).
- [52] G.V. Naidis, Plasma Sources Sci. Technol. 19, 055010 (2010).

- [53] 寺本慶之,小野 亮,小田哲治:電気学会論文誌 A (掲 載予定).
- [54] G. Hartmann and I. Gallimberti, J. Phys. D: Appl. Phys., 8, 670 (1975).
- [55] G.D. Billing, Chem. Phys. 43, 395 (1979).
- [56] C. Coletti and G.D. Billing, Chem. Phys. Lett. 356, 14 (2002).
- [57] A. Komuro, R. Ono and T. Oda, Plasma Sources Sci. Technol. 19, 055004 (2010).
- [58] D.L. Huestis, J. Phys. Chem. A 110, 6638 (2006).
- [59] J. Finzi, F.E. Hovis, V.N. Panfilov, P. Hess and C.B. Moore, J. Chem. Phys. 67, 4053 (1977).
- [60] P.F. Zittel and D.E. Masturzo, J. Chem. Phys. 90, 977 (1989).
- [61] M.E. Whitson Jr and R.J. McNeal, J. Chem. Phys. 66, 2696 (1977).
- [62] R. Ono and T. Oda, Jpn. J. Appl. Phys. 43, 321 (2004).
- [63] R. Ono, Y. Teramoto and T. Oda, J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 345203 (2010).
- [64] T.F. O'Malley, Phys. Rev. 155, 59 (1967).
- [65] W.R. Henderson, W.L. Fite and R.T. Brackmann, Phys. Rev. 183, 157 (1969).
- [66] J.M. Wadehra and J.N. Bardsley, Phys. Rev. Lett. 41, 1795 (1978).
- [67] R. Ono and T. Oda, Plasma Sources Sci. Technol. 18, 035006 (2009).
- [68] 田中邦理, 寺本慶之, 小野 亮, 小田哲治: 静電気学会 講演論文集2010 201 (2010).
- [69] 流れの可視化学会編:流れの可視化ハンドブック,第 8章(朝倉書店,1986).
- [70] G.A. Woolsey, S.J. MacGregor and O. Farish, Proc. R. Soc. Lond. A 405, 355 (1986).
- [71] H. Tajalli, D.W. Lamb and G.A. Woolsey, J. Phys. D: Appl. Phys. 22, 1497 (1989).
- [72] S. Kacem, O. Ducasse, O. Eichwald, N. Renon, H. Bensaad, K. Charradaand M. Yousfi, *Proceedings of the 18th International Confefence on Gas Discharges and Their Applications* (2010), p.276.



* の りょう

東京大学新領域創成科学研究科先端エネル ギー工学専攻准教授.博士(工学).2000年 に東京大学工学系研究科電気工学専攻博士 課程修了後,同大新領域創成科学研究科先

端エネルギー工学専攻助手,産業技術総合研究所爆発安全研 究センター研究員,東京大学高温プラズマ研究センター助教 授を経て現職.コロナ放電,バリア放電,プラズマジェット,大 気圧グロー放電など大気圧低温プラズマの基礎と応用,水素 の放電着火,色素増感太陽電池の開発などに従事.大気圧プ ラズマの化学特性をいかした応用分野の開発にも興味がある.